

**Физика и техника полупроводников,
2017, том 51, выпуск 6**

XV Международная конференция "Термоэлектрики и их применения --- 2016" , Санкт-Петербург, 15- 16 ноября 2016 г.

Бурков А.Т., Новиков С.В., Зайцев В.К., Рейсс Х.

XV Международная конференция "Термоэлектрики и их применения --- 2016", Санкт-Петербург, 15-16 ноября 2016 г. Низкотемпературный транспорт в моносилциде кобальта и сплавах на его основе

723

Лукьянова Л.Н., Бойков Ю.А., Усов О.А., Данилов В.А.

Эффективная масса плотности состояний и подвижность носителей заряда в гетероэпитаксиальных пленках теллурида висмута и твердых растворах $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$

726

Булат Л.П., Пшеная-Северин Д.А., Освенский В.Б., Пархоменко Ю.Н.

Расчет теплопроводности наноструктурированного Bi_2Te_3 с учетом реального фононного спектра

729

Урюпин О.Н., Шабалдин А.А.

Термоэлектрические свойства $\text{InSb}<\text{Zn}>$ в нанопористом стекле

733

Комаров В.А., Суслов А.В., Суслов М.В.

Гальваномангнитные свойства тонких пленок $\text{Bi}_{85}\text{Sb}_{15}$ на различных подложках

736

Орехов А.С., Камилов Т.С., Ибрагимова Б.В., Ивакин Г.И., Клечковская В.В.

Структура термоэлектрических пленок высшего силицида марганца на кремнии по данными электронной микроскопии

740

Япрынцева М.Н., Любушкин Р.А., Соклакова О.Н., Иванов О.Н.

Синтез и электрофизические свойства термоэлектрического материала на основе Bi_2Te_3 , легированного лантаноидами Er, Tm, Yb и Lu

744

Панченко В.П., Табачкова Н.Ю., Иванов А.А., Сенатулин Б.Р., Андреев Е.А.

Получение и свойства термоэлектрического материала на основе Zn_4Sb_3

748

Ховайло В.В., Воронин А.И., Зуева В.Ю., Середина М.А., Чаттерджи Р.

Полупроводниковые сплавы Гейслера на основе Fe

752

Булат Л.П., Новотельнова А.В., Освенский В.Б., Тукмакова А.С., Ережеп Д.

Моделирование активированного электрическим полем спекания термоэлектриков

756

Яковлева Г.Е., Романенко А.И., Бердинский А.С., Кузнецов В.А., Леднева А.Ю., Артемкина С.Б., Федоров В.Е.

Влияние катионного и анионного замещений в дисульфиде и диселениде вольфрама на электропроводность и термоэдс

759

Лукьянова Л.Н., Бибики А.Ю., Асеев В.А., Усов О.А., Макаренко И.В., Петров В.Н., Никоноров Н.В.

Морфология межслоевой поверхности и микро-рамановские спектры в слоистых пленках топологических изоляторов на основе теллурида висмута

763

Публикация материалов Конференции завершена.	
Неэлектронные свойства полупроводников (атомная структура, диффузия)	
Алыев Ю.И., Асадов Ю.Г., Алыева Р.Д., Джабаров С.Г.	
Полиморфные превращения и термическое расширение кристаллов $\text{AgCuSe}_{0.5}(\text{S,Te})_{0.5}$	766
Алексеев И.В., Горемычкин Е.А., Гундорин Н.А., Петренко А.В., Сашин И.Л.	
Детектор нейтронов на основе кристаллов TlInSe_2, интеркалированных изотопом лития	773
Кожемяко А.В., Балакшин Ю.В., Шемухин А.А., Черныш В.С.	
Изучение профиля распределения железа, имплантированного в кремний	778
Электронные свойства полупроводников	
Ницук Ю.А., Ваксман Ю.Ф.	
Электрофизические свойства кристаллов ZnSe, легированных переходными элементами	783
Рехвиашвили С.Ш., Алиханов А.А.	
Моделирование диффузионно-дрейфового транспорта носителей заряда в полупроводниковых слоях с фрактальной структурой в переменном электрическом поле	787
Галиев Г.Б., Клочков А.Н., Васильевский И.С., Климов Е.А., Пушкарев С.С., Виниченко А.Н., Хабибуллин Р.А., Мальцев П.П.	
Электронные свойства приповерхностных квантовых ям InGaAs/InAlAs с инвертированным легированием на подложках InP	792
Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления	
Алексеев П.С., Горный И.В., Дмитриев А.П., Качоровский В.Ю., Семина М.А.	
Классическое магнетосопротивление двухкомпонентной системы, обусловленное термоэлектрическими эффектами	798
Аморфные, стеклообразные, органические полупроводники	
Мехтиева С.И., Атаева С.У., Исаев А.И., Зейналов В.З.	
Влияние примеси самария на структуру и морфологию поверхности халькогенидного стеклообразного полупроводника $\text{Se}_{95}\text{Te}_5$	809
Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники	
Басалаев Ю.М., Копытов А.В., Поплавной А.С., Польшгалов Ю.И.	
Первопринципное исследование электронного и колебательного строений тетрагонального диарсенида кадмия	815
Физика полупроводниковых приборов	
Клочко Н.П., Копач В.Р., Хрипунов Г.С., Корсун В.Е., Волкова Н.Д., Любов В.Н., Кириченко М.В., Копач А.В., Жадан Д.О., Отченашко А.Н.	
Барьерная гетероструктура $n\text{-ZnO}/p\text{-CuI}$ на основе электроосажденных в импульсном режиме наномассивов оксида цинка и изготовленных методом SILAR пленок иодида меди	821
Мнацаканов Т.Т., Левинштейн М.Е., Шуман В.Б., Середин Б.М.	
О пределе инжектирующей способности кремниевых $p\text{-}n$-переходов, обусловленном влиянием фундаментальных физических эффектов	830

Горбатюк А.В., Иванов Б.В.

Имитационное моделирование реверсивно-включаемых диристоров в режимах со сниженным порогом первичного запуска

835

Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур

Бучин Э.Ю., Наумов В.В., Васильев С.В.

Влияние постоянного магнитного поля на формирование силицидных фаз в структуре Si/Si(100) при изотермическом отжиге

844

Кобзиев В.Ф., Закирова Р.М., Костенков Н.В., Крылов П.Н., Федотова И.В.

Влияние температуры осаждения на структуру и оптические свойства пленок селенида цинка, полученных ВЧ магнетронным распылением

850

Кириенко Д.А., Березина О.Я.

Отделение тонких пленок ITO от кремниевой подложки с помощью микросекундного лазерного облучения

855

Аннотации статей, поступивших в Редакцию журнала на английском языке. Полные тексты этих статей опубликованы в переводной версии журнала "Физика и техника полупроводников" --- SEMICONDUCTORS

Kaminskii V.V., Solov'ev S.M., Khavrov G.D., Sharenkova N.V., Hirai Shinji

Structural Features of Sm_{1-x}Eu_xS Thin Polycrystalline Films

860